

### Сведения об официальном оппоненте

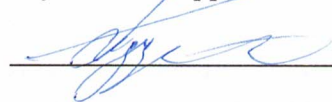
По диссертации Ванькова Александра Борисовича на тему «Оптическая спектроскопия сильнокоррелированных двумерных электронных систем в квантующем магнитном поле», представленной к защите на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 1.3.8 – «Физика конденсированного состояния».

Фамилия Имя Отчество	Пудалов Владимир Моисеевич
Год рождения, гражданство	1945, РФ
Учёная степень (отрасль наук)	Доктор физико-математических наук (физика)
Наименование специальности, по которой защищена диссертация	Физика низких температур и криогенная техника
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН
Должность	Главный научный сотрудник
Структурное подразделение	Центр им. В.Л. Гинзбурга
Почтовый адрес	119991, ГСП-1 Москва, Ленинский проспект, д.53
Официальный сайт	<a href="https://www.lebedev.ru/">https://www.lebedev.ru/</a>
Электронная почта	pudalov@lebedev.ru
Контактный телефон	+7(903)228-9611

Список основных публикаций по тематике диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

1. On the origin of the temperature dependence of spin susceptibility in correlated 2D electron system. V.M. Pudalov, M. Gershenson, A.Yu. Kuntsevich, N. Tenen, M. Reznikov, <i>Journal of Magnetism and Magnetic Materials</i> , 2018, v.459, p.265-267.
2. Two-dimensional semimetal in HgTe quantum well under hydrostatic pressure. V. A. Prudkoglyad, E. B. Olshanetsky, Z. D. Kvon, V. M. Pudalov, N. N. Michailov, S. A. Dvoretzky, <i>Physical Review B</i> , 2018, v.98, p.155437
3. Probing spin susceptibility of a correlated two-dimensional electron system by transport and magnetization measurements. V.M. Pudalov, A.Yu. Kuntsevich, M.E. Gershenson, I.S. Burmistrov, and M. Reznikov, <i>Physical Review B</i> , 2018, v.98, p.155109.
4. Experimental Evidence for an Inhomogeneous State of the Correlated Two-Dimensional Electron System in the Vicinity of a Metal–Insulator Transition. V. M. Pudalov, and M. E. Gershenson, <i>JETP Letters</i> , 2020, v.111, No.4, pp. 225–229.
5. Magnetic-field-driven redistribution between extended and localized electronic states in high-mobility Si MOSFETs at low temperatures. V.M. Pudalov, M.E. Gershenson, <i>Physical Review B</i> , 2021, v.104, p.035407.
6. On the Percolation Regime of the Bulk Transport of the Bi <sub>1.08</sub> Sn <sub>0.02</sub> Sb <sub>0.9</sub> Te <sub>2</sub> S Topological Insulator. V. Sakhin, E. Kukovitsky, Y. Talanov, G. Teitel'baum, L. Morgun, A. Borisov, A. Usoltsev, V. Pudalov, <i>JETP Letters</i> , 2022, v.115, №4, p.239

Главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения науки Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН доктор физико-математических наук, член-корреспондент РАН



Пудалов Владимир Моисеевич

Подпись Пудалова Владимира Моисеевича удостоверяю  
Ученый секретарь ФИАН  
К.ф.-м.н.



Колобов А.В.

«12» сентября 2023 г.

Печать организации